

令和5年度

製品名	SiCウエハー加工装置	<p>GHOST New wafer processing technology for SiC インゴット外周溝加工 インゴット外周溝加工方法</p> <p>研磨砥石 SiCインゴット</p> <p>ワイヤースライス 通常のインゴット 溝加工インゴット ワイヤー走行方向 インゴット移動方向</p> <p>ワイヤースライス インゴット スライス終了時に1次面取りが終了しています ワイヤー 溝に沿ってスライス 面取り済み インゴットの移動方向</p>
会社名	有限会社ドライケミカルズ	
製品の紹介	次世代パワー半導体用のSiCウエハー製造コストを低減する工程を開発したもの。同材料は非常に硬く、インゴットからスライスする際の生産ロスが課題だったが、スライス前に砥石によりインゴット外周へ溝加工を施すことで高精度・高効率なスライスを可能にした。	
センターの役割	形状測定及び断面観察による加工精度評価	
その他連携機関		